

半 导 体 学 报

第 11 卷 第 3 期 1990 年 3 月

目 录

- MOCVD 生长的 II-VI 族化合物固溶体组分的热力学分析 I. ZnS_xSe_{1-x} 体系
.....陆大成 (163)
- 掺铁半绝缘磷化铟的深能级研究.....彭 承 李建林 陆 峻 孙恒慧 (170)
- $Ga_{1-x}Al_xAs$ Raman 散射的共振和反共振.....王笑军 张新夷 (176)
- Ge 中热空穴输运的格林函数方法.....唐 刚 徐婉棠 (182)
- TEA CO_2 激光诱发 SiH_4 等离子体发光动力学研究
-傅广生 董丽芳 李晓苇 韩 理 张连水 吕福润 (193)
- GaAs/ GaAlAs 单量子阱电光吸收和光调制.....
-朱龙德 熊飞克 王启明 陈正豪 谢苑林 顾世杰 (202)
- 与光探测器单片集成双稳半导体激光器的特性.....晏绪光 稻场文男 (210)
- 衬底预非晶化对低能硼注入硅形成浅结的影响.....
-卢志恒 李素杰 张朝明 罗 晏 张荟星 (215)
- 砷化镓材料中 EPR“ As_G ” 的退火行为.....汪光裕 邹元熾
- S. Benakki, E. Christoffel, A. Goltzene, B. Meyer and C. Schwab (221)
- 一种带权动态调整的总体布线算法及其实现.....王维丽 洪先龙 (227)
- 研究简报**
- GaInPAs/InP 晶格匹配超晶格材料电子态研究.....沈静志 徐至中 (233)
- 研究快报**
- 嵌入在 Si 衬底上的分子束外延 GaAs 层的微区喇曼和光致发光分析.....
-李国华 梁基本 韩和相 汪兆平 孔梅影 (238)